

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2014년 3월 27일 (27.03.2014)



(10) 국제공개번호
WO 2014/046373 A1

- (51) 국제특허분류:
H01L 51/52 (2006.01) *H05B 33/26* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2013/004975
- (22) 국제출원일: 2013년 6월 5일 (05.06.2013)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2012-0103754 2012년 9월 19일 (19.09.2012) KR
- (71) 출원인: 고려대학교 산학협력단 (KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION) [KR/KR]; 136-701 서울시 성북구 안암동 5가 1, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 김태근 (KIM, Tae Geun); 463-905 경기도 성남시 분당구 이매동 청구아파트 601-1105, Gyeonggi-do (KR). 김희동 (KIM, Hee-Dong); 136-713 서울시 성북구 안암동 5가 고려대학교자연계캠퍼스 공학관 436호, Seoul (KR).

(74) 대리인: 특허법인주원 (B&IP-JOOWON PATENT AND LAW FIRM); 135-701 서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 9층 (논현동), Seoul (KR).

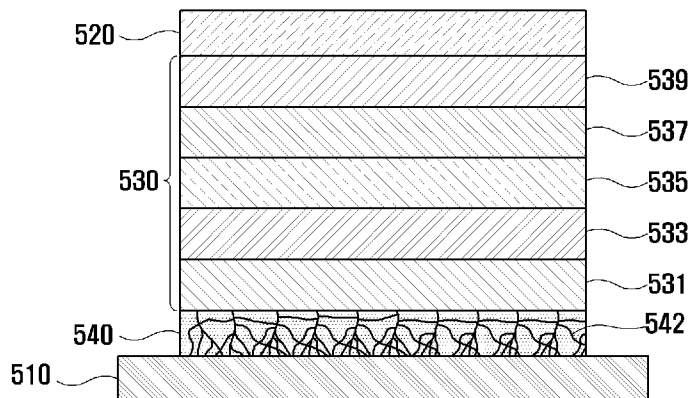
(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[다음 쪽 계속]

(54) Title: ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE PROVIDED WITH TRANSPARENT ELECTRODE HAVING CONDUCTIVE FILAMENTS AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 발명의 명칭 : 전도성 필라멘트가 형성된 투명 전극을 구비하는 유기 발광소자 및 그 제조 방법



(57) Abstract: Disclosed are an organic light-emitting diode provided with a transparent electrode having conductive filaments and a method for manufacturing the same. The present invention has a transparent electrode of the organic light-emitting diode, wherein the transparent electrode has high transmittance for light in an ultraviolet region, has conductive filaments therein through which currents flow when a voltage that exceeds an intrinsic critical voltage is applied to a material, and is formed from a resistance change material for changing a resistance state of the material from a high resistance state to a low resistance state such that the present invention can obtain a transparent electrode which can exhibit high light transmittance for light in a visible light region and light in an ultraviolet region and can show high electric conductivity through ohmic contact with organic layers that constitute an organic semiconductor layer. Furthermore, the present invention enables conductive filaments formed inside the transparent electrode to be connected with each other by forming a current diffusing layer implemented as graphene or CNT with excellent conductive and light transmittance characteristics on the upper or lower part of the transparent electrode, so that a current concentration can be prevented by diffusing, to all of the organic layers, currents introduced to the transparent electrode.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]



WO 2014/046373 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, **공개:**
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

본 발명은 전도성 필라멘트가 형성된 투명 전극을 구비하는 유기 발광소자 및 그 제조 방법을 공개한다. 본 발명은 자외선 영역의 빛에 대한 투과도가 높고, 물질에 고유한 임계전압을 초과하는 전압이 인가되면, 내부에 전류가 흐를 수 있는 전도성 필라멘트가 형성되어, 물질의 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 저항변화 물질로 유기 발광소자의 투명 전극을 형성함으로써, 유기 발광소자에서 발생하는 가시광선 영역의 빛뿐만 아니라 자외선 영역의 빛에 대해서도 높은 광투과율을 나타낼뿐만 아니라, 유기 반도체층을 구성하는 유기물층과 오믹 콘택이 이루어져 전기 전도도가 양호한 투명 전극을 얻을 수 있다. 또한, 본 발명은 투명 전극의 상부 또는 하부에 전도성 및 광투과도 특성이 우수한 CNT 또는 그래핀으로 구현되는 전류 확산층을 형성하여 투명 전극 내부에 형성된 전도성 필라멘트들을 상호 연결시킴으로써 투명 전극으로 유입된 전류를 유기물층 전체로 확산시켜 전류 집중 현상을 방지할 수 있다.

명세서

발명의 명칭: 전도성 필라멘트가 형성된 투명 전극을 구비하는 유기 발광소자 및 그 제조 방법

기술분야

- [1] 본 발명은 유기 발광 소자 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 오믹 콘택 특성 및 광투과도가 양호한 투명 전극을 구비하는 발광소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 최근 정부의 저탄소 녹색성장 정책기조에 부응하여 반도체 광원인 LED (Light Emitting Diode) 와 OLED (Organic Light Emitting Diode) 조명이 주목받고 있다. 반도체 조명은 친환경 조명으로 수은과 납과 같은 환경유해물질이 포함되어 있지 않으며, 저소비전력형 조명으로 기존 전통조명보다 전력효율이 월등히 높다. 특히 점광원인 LED와 달리 OLED는 얇은 면광원의 형태를 가지며 기존 광원이 구현하기 힘든 투명하면서 유연한 조명이 가능하다.
- [3] 또한, OLED는 투명 FLEXIBLE 조명으로 신개념 smart window, 두루마리처럼 말아서 휴대할 수 있는 조명, 커튼조명 등에 응용될 수 있어 최근 활발한 연구가 진행되고 있다.
- [4] 하지만, OLED가 여러 분야에서 응용되기 위해서는, 투명전극과 유기반도체 사이의 낮은 오믹특성으로 인한 높은 구동 전압의 문제점이 해결되어야 한다. OLED의 구동 전압은 크게 전하의 주입과 이동에 의하여 결정되며, 구동전압 개선을 위해서는 이 두 가지 특성이 모두 개선되어야 한다.
- [5] 전하의 주입 특성은 전극과 유기반도체 사이의 에너지 준위에 의하여 결정되므로, 각 층간의 에너지 장벽 차이를 줄여 오믹접촉을 형성하면 원활한 전하의 주입과 이동이 가능하여 낮은 구동 전압에서 소자를 구현할 수 있다.
- [6] 그러나, 현재 OLED에서 투명 전극으로 주로 이용되는 ITO(4.3eV)는 유기반도체(6.3eV)와의 큰 일함수 차이로 인하여 오믹 특성이 저하되고, 이에 따라서 전하 주입 효율이 낮은 문제점이 발생하고 있다. 또한, ITO는 자외선 영역에서 높은 투과도 손실을 가지기 때문에 현재 Organic UV-LED는 낮은 광추출 효율의 문제점이 발생한다.
- [7] 이를 해결하기 위해서는, 투명전극으로 사용되는 ITO와 유기반도체 사이에 오믹 접촉을 형성하여 원활한 전하 주입이 이루어져야 하는데, 현재 일반적으로 적용되는 투명전극은 투과도와 전기 전도도 사이의 Trade-off 관계를 갖는다. 즉, 자외선 영역에서 이용될 수 있을 만큼 높은 투과도를 가지는 물질은 큰 밴드갭(wide band-gap)을 가지므로, 전극으로 이용되기에는 전도성이 매우 낮고 반도체 물질과 Ohmic contact 이 이루어지지 않아 전극으로 이용하는 것이 불가능하다.

- [8] 현재의 기술로는 가시광 영역뿐만 아니라 자외선 영역에서도 높은 투과도를 나타내면서도, Ohmic contact 이 이루어져 높은 전기전도도를 나타내는 투명 전극을 구현할 수 없다. 따라서, 가시광 영역부터 UV 영역까지 적용될 수 있는 OLED를 구현하기 위해서는, 높은 투과도를 지니는 동시에 유기반도체층과 오믹 접촉 형성이 가능한 투명전극 개발이 필수적이다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [9] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 자외선 영역의 빛에 대해서도 높은 투과도를 나타내면서도 유기 반도체층과 양호한 오믹 콘택 특성을 나타내는 투명 전극을 구비하는 유기 발광소자 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제 해결 수단

- [10] 상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 유기 발광 소자는, 기판; 상기 기판 위에 형성되고, 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연 물질로 형성된 제 1 전극; 상기 제 1 전극 위에 형성되고, 내부에 발광층을 포함하는 유기물층; 및 상기 유기물층 위에 형성되는 제 2 전극;을 포함한다.
- [11] 또한, 상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 바람직한 실시예에 따른 유기 발광 소자는 기판; 상기 기판위에 형성된 제 2 전극; 상기 제 2 전극 위에 형성되고, 내부에 발광층을 포함하는 유기물층; 및 상기 유기물층 위에 형성되고, 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연 물질로 형성된 제 1 전극;을 포함한다.
- [12] 또한, 상기 유기 발광 소자들의 제 1 전극은 고유한 임계 전압 이상의 전압이 인가되어 포밍(forming) 공정이 수행됨으로써, 내부에 전도성 필라멘트가 형성될 수 있다.
- [13] 또한, 상기 유기 발광 소자들의 상기 유기물층과 상기 제 1 전극 사이에 CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 형성되는 전류확산층을 더 포함할 수 있다.
- [14] 또한, 상기 유기 발광 소자들은 상기 제 1 전극의 상기 유기물층이 접촉하는 면의 반대면에 접촉하고, CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 형성되는 전류확산층을 더 포함할 수 있다.
- [15] 또한, 상기 유기 발광 소자들의 상기 제 1 전극은 상기 유기물층과 오믹 콘택될 수 있다.
- [16] 또한, 상기 유기 발광 소자들의 상기 제 1 전극은 투명한 Oxide 계열의 물질, 투명한 Nitride 계열의 물질, 투명한 폴리머 계열의 물질, 및 투명한 나노 물질들 중 어느 하나로 형성될 수 있다.
- [17] 또한, 상기 유기 발광 소자들의 상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 및 전자 주입층을 포함할 수 있다.

- [18] 한편, 상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 유기 발광 소자 제조 방법은, 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 기판 위에 형성하는 제 1 전극 형성 단계; 내부에 발광층을 포함하는 유기물층을 상기 제 1 전극 위에 형성하는 유기물층 형성 단계; 및 상기 유기물층 위에 제 2 전극을 형성하는 제 2 전극 형성 단계를 포함할 수 있다.
- [19] 한편, 상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 따른 유기 발광 소자 제조 방법은, 기판 위에 제 2 전극을 형성하는 제 2 전극 형성 단계; 내부에 발광층을 포함하는 유기물층을 상기 제 2 전극 위에 형성하는 유기물층 형성 단계; 및 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 상기 유기물층 위에 형성하는 제 1 전극 형성 단계;를 포함할 수 있다.
- [20] 또한, 상기 유기 발광 소자 제조 방법들의 제 1 전극 형성 단계는, 상기 제 1 전극에 임계 전압 이상의 전압을 인가함으로써 포밍(forming) 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극 내부에 전도성 필라멘트를 형성할 수 있다.
- [21] 또한, 상기 유기 발광 소자 제조 방법들의 제 1 전극 형성 단계는, CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 전류 확산층을 형성하는 단계; 상기 전류 확산층 위에 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 형성하는 단계; 및 상기 제 1 전극에 임계 전압 이상의 전압을 인가함으로써 포밍(forming) 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극 내부에 전도성 필라멘트를 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
- [22] 또한, 상기 유기 발광 소자 제조 방법들의 제 1 전극 형성 단계는, 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 형성하는 단계; 상기 제 1 전극에 임계 전압 이상의 전압을 인가함으로써 포밍(forming) 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극 내부에 전도성 필라멘트를 형성하는 단계; 및 상기 제 1 전극 위에, CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 전류 확산층을 형성하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [23] 또한, 상기 유기 발광 소자 제조 방법들에서 형성되는 상기 제 1 전극은 상기 유기물층과 오믹 콘택될 수 있다.
- [24] 또한, 상기 유기 발광 소자 제조 방법들에서 형성되는 상기 제 1 전극은 투명한 Oxide 계열의 물질, 투명한 Nitride 계열의 물질, 투명한 폴리머 계열의 물질, 및 투명한 나노 물질들 중 어느 하나로 형성될 수 있다.
- [25] 또한, 상기 유기 발광 소자 제조 방법들의 상기 유기물층 형성 단계에서는, 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 및 전자 주입층이 순차적으로 형성될 수 있다.

발명의 효과

- [26] 본 발명은 자외선 영역의 빛에 대한 투과도가 높고, 물질에 고유한 임계전압을

초과하는 전압이 인가되면, 내부에 전류가 흐를 수 있는 전도성 필라멘트가 형성되어, 물질의 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 저항변화 물질로 유기 발광소자의 투명 전극을 형성함으로써, 유기 발광소자에서 발생하는 가시광선 영역의 빛뿐만 아니라 자외선 영역의 빛에 대해서도 높은 광투과율을 나타낼뿐만 아니라, 유기 반도체층을 구성하는 유기물층과 양호한 오믹 컨택이 이루어져 전기 전도도가 양호한 투명 전극을 얻을 수 있고, 이에 따라서 구동 전압을 낮출수 있다.

- [27] 또한, 본 발명은 투명 전극의 상부 또는 하부에 전도성 및 광투과도 특성이 우수한 CNT 또는 그래핀으로 구현되는 전류 확산층을 형성하여 투명 전극 내부에 형성된 전도성 필라멘트들을 상호 연결시킴으로써 투명 전극으로 유입된 전류를 유기물층 전체로 확산시켜 전류 집중 현상을 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [28] 도 1은 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 투명 전극을 구비하는 유기 발광소자의 구조를 도시하는 도면이다.
- [29] 도 2a 및 도 2b 는 저항 변화 물질의 특성을 설명하는 도면이다.
- [30] 도 3은 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 유기 발광소자를 제조하는 방법을 설명하는 도면이다.
- [31] 도 4a 및 도 4b는 본 발명의 바람직한 제 1 실시예의 변형 실시예의 유기 발광소자의 구성을 도시하는 도면이다.
- [32] 도 5는 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 투명 전극을 구비하는 유기 발광소자의 구조를 도시하는 도면이다.
- [33] 도 6은 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 유기 발광소자의 제조 방법을 설명하는 도면이다.
- [34] 도 7a 및 도 7b는 본 발명의 바람직한 제 2 실시예의 변형 실시예에 따른 유기 발광소자의 구조를 도시하는 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [35] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명한다.
- [36] 도 1은 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 투명 전극(140)을 구비하는 유기 발광소자의 구조를 도시하는 도면이다.
- [37] 도 1을 참조하면, 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 유기 발광소자는 Top-emission 방식의 유기 발광 소자로서, 기판(110)위에 제 2 전극(120) 및 발광층(135)을 포함하는 유기물층(130)이 순차적으로 형성되어 있고, 유기물층(130)은 정공 주입층(131), 정공 수송층(133), 발광층(135), 전자 수송층(137) 및 전자 주입층(139)이 순차적으로 형성된 구조로 구현될 수 있으며, 이하에서는 유기물층(130)이 정공 주입층(131) 내지 전자 주입층(139)을 포함하는 경우를 예시적으로 설명한다. 기판(110)부터 전자 주입층(139)까지의 구성은 현재 공지된 모든 유기 발광소자에 적용되는 구조가 동일하게 적용될 수

있다.

- [38] 한편, 전자 주입층(139) 위에는 본 발명의 투명한 재질의 제 1 전극(140:이하 "투명 전극"으로 칭함)이 형성되어 있다. 본 발명의 투명 전극(140)은 자외선 영역을 포함하는 빛에 대한 투과도가 높으면서도 인가된 전계에 의해서 저항상태가 변화되는 투명 재질의 절연 물질(저항 변화 물질)로 형성된다. 이러한, 저항 변화 물질은 주로 ReRAM(Resistive RAM) 분야에서 이용되는 것으로서, 물질에 고유한 임계치 이상의 전압을 물질에 인가하면, electro-forming이 수행되어, 최초에는 절연체인 물질의 저항 상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되어 전도성을 나타내게 된다.
- [39] 구체적으로, 절연체인 저항 변화 물질에 임계치 이상의 전압을 인가하면, 전기적 스트레스(forming process)에 의해 박막 내부로 전극 금속 물질이 삽입되거나 박막내 결함구조에 의해 도 1에 도시된 바와 같이 저항 변화 물질 내부에 전도성 필라멘트(142:conducting filaments)(또는, 금속 필라멘트(metallic filaments))가 형성된다. 이 후에는, 물질에 인가된 전압이 제거되어도 전도성 필라멘트(142)는 유지되고, 이러한 전도성 필라멘트(142)를 통해서 전류가 흐르게 되어, 물질의 저항 상태가 저저항 상태로 유지된다.
- [40] 도 2a 및 도 2b 는 저항 변화 물질의 특성을 설명하는 도면이다.
- [41] 도 2a를 참조하면, 저항 변화 물질(예컨대, AlN)은 forming과정 전에는 절연체 특성을 보이다가 forming 과정 이후 금속의 I-V 특성을 나타냄을 확인 할 수 있다.
- [42] 도 2b는 전도성 필라멘트(142)가 형성된 후 얼마나 안정적으로 유지 될 수 있는가를 보여 주는 그래프로서, 그래프의 빨간색 점선이 보여 주는 것과 같이 전도성 필라멘트(142)가 형성 된 후 10년 동안 안정적으로 저저항 상태가 유지 될 수 있음을 알 수 있다.
- [43] 본 발명의 바람직한 실시예에서는, 이러한 저항 변화 물질로서, 투명한 전도성 Oxide 계열의 물질(SiO₂, Ga₂O₃, Al₂O₃, ZnO, ITO 등), 투명한 전도성 Nitride 계열의 물질(Si₃N₄, AlN, GaN, InN 등), 투명한 전도성 폴리머 계열의 물질(polyaniline(PANI)), poly(ethylenedioxythiophene)-polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS 등), 및 투명한 전도성 나노 물질(CNT, CNT-oxide, Graphene, Graphene-oxide 등) 등을 이용하였으나, 상술한 물질 이외에도 투명하고 상술한 저항 변화 특성을 나타내는 물질이라면 본 발명의 투명 전극(140)을 형성하는데 이용될 수 있음은 물론이다. 다만, 상기 물질들이 전도성을 갖는다는 의미는, 포밍(forming) 공정에 의해서 내부에 전도성 필라멘트(142)가 형성된 이 후에, 전도성을 갖는다는 의미이고, 본 발명의 투명 전극(140)은 포밍 공정이 수행되어, 내부에 전도성 필라멘트가 형성된 것임을 주의해야 한다.
- [44] 도 1에 도시된 바와 같이 유기 발광 소자가 완성되면, 투명 전극(140)으로 주입된 전류는 투명 전극(140) 내부에서 서로 연결된 전도성 필라멘트(142)를 통해서 전체 영역으로 확산되어 전자 주입층(139) 전체 영역으로 주입되고, 자외선 영역의 빛을 포함한 발광층(135)에서 발생된 모든 빛은 밴드 갭이 큰 투명

전극(140)을 통해서 상부로 유출된다.

[45]

[46] 도 3은 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 유기 발광소자를 제조하는 방법을 설명하는 도면이다.

[47] 도 3을 참조하여 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 유기 발광소자의 제조 방법을 설명하면, 먼저, 종래의 유기 발광소자 제조 방법과 동일한 방식으로 기판(110)위에 제 2 전극(120) 및 발광층(135)을 포함하는 유기물층(130)을 형성한다(도 3의 (a)참조). 상술한 바와 같이, 유기물층(130)은 정공 주입층(131), 정공 수송층(133), 발광층(135), 전자 수송층(137) 및 전자 주입층(139)이 순차적으로 형성된 구조로 구현될 수 있고, 종래의 투명 전극(140) 형성 방식과 동일한 방식으로 상술한 바와 같은 저항 변화 물질로 유기물층(130)(특히, 전자 주입층(139)) 위에 제 1 전극(140:이하, "투명 전극"이라 칭함)을 형성한다.

[48] 그 후, 투명 전극(140) 위에 포토레지스트층(180)을 형성하고, 포토 리소그래피 공정을 수행하여 포토레지스트층(180) 중에서 금속 패드(170)가 형성될 영역의 일부에 포밍 전극(182)을 형성하기 위한 패턴을 형성하고(도 3의 (b)참조), e-beam, 스퍼터 또는 기타 금속 증착 공정을 수행하여 패턴 내부에 포밍 전극(182)을 형성한 후, lift-off 공정을 통해서 포밍 전극(182)을 제외한 포토레지스트층(180)을 제거하여 포밍 전극(182)을 완성한다(도 3의 (c)참조).

[49] 그 후, 도 3의 (d)에 도시된 바와 같이, 투명 전극(140) 위에 형성된 포밍 전극(182)에 물질에 고유한 임계 전압 이상의 전압을 인가하면, 절연물질인 투명 전극(140) 내부에 전도성 필라멘트(142)가 형성되어, 투명 전극(140)의 저항 상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화된다.

[50] 투명 전극(140) 내부에 전도성 필라멘트(142)가 형성되면, 투명 전극(140) 위에 금속 전극 패드(170)를 형성한다(도 3의 (e)참조). 이 때, 금속 전극 패드(170)를 형성하는 방법은 포밍을 수행하기 위한 전극(182)을 제거하고 별도의 금속 전극 패드(170)를 형성할 수도 있고, 도 3의 (e)에 도시된 바와 같이, 마스크(184)를 이용하여 포밍 전극(182) 위에 추가로 금속을 증착하여 금속 전극 패드(170)를 형성할 수도 있다.

[51]

[52] 지금까지 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 유기 발광소자 및 그 제조 방법에 대해서 설명하였다. 도 1 내지 도 3을 참조하여 상술한 제 1 실시예에서, 투명 전극(140)내에 형성된 일부 전도성 필라멘트(142)는 다른 전도성 필라멘트들(142)과 연결되지 않을 가능성이 있다. 이 경우, 투명 전극(140)으로 유입되는 전류가 투명 전극(140) 전체로 확산되지 못하고 국부적으로 집중되고, 이에 따라서 투명 전극(140)에 접촉하는 전자 주입층(139)에도 국부적으로 전류가 집중되는 문제점이 발생할 수도 있다.

[53] 도 4a 및 도 4b는 이러한 전류 집중 문제를 해결하기 위한 본 발명의 바람직한 제 1 실시예의 변형 실시예에 따른 유기 발광소자의 구성을 도시하였다.

- [54] 도 4a 및 도 4b에 도시된 예에서는, 투명 전극(140)의 전류 확산 특성(current spreading)을 향상시키기 위해서, 투명 전극(140)에 형성된 전도성 필라멘트들(142)을 상호 연결시키는 CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀(graphene)으로 구현되는 전류 확산층(150)을 투명 전극(140)의 상면 또는 하면에 형성하였다. 도 4a에서는 CNT 또는 그래핀으로 구현되는 전류 확산층(150)을 투명 전극(140)위에 형성한 예를 도시하였고, 도 4b에서는 CNT 또는 그래핀으로 구현된 전류 확산층(150)을 투명 전극(140)층과 전자 주입층(139) 사이에 형성한 예를 도시하였다.
- [55] CNT 및 그래핀은 전도성 및 빛의 투과도가 뛰어난 특성이 있고, 본 발명은 이러한 특성을 이용하여 투명 전극(140)의 일면에 접촉하도록 CNT 또는 그래핀으로 전류 확산층(150)을 형성하여 투명 전극(140)의 전도성 필라멘트(142)를 상호 연결함으로써, 투명 전극(140)으로 유입된 전류가 전자 주입층(139) 전체 영역으로 확산되도록 하였다.
- [56] 이 때, 전류 확산층(150)이 두껍게 형성될수록 내부의 CNT 및 그래핀이 상호 연결되고, 이에 따라서 전도성 필라멘트들(142)이 상호 연결될 확률이 높아져서 투명 전극(140)의 전도성은 향상되지만 투과도가 낮아진다. 따라서, 본 발명의 전류 확산층(150)은 투명 전극(140)의 전도성 필라멘트들(142)을 상호 연결시키기에 충분하면서도 투과도가 저해되지 않는 한도내에서 가능한 얇게 형성되는 것이 바람직하다.
- [57] 도 4a 및 도 4b에 도시된 본 발명의 실시예에서는, 약 2nm 내지 약 100nm 의 두께로 전류 확산층(150)을 형성하였다. 2nm는 CNT 및 그래핀을 단일층으로 형성할 수 있는 최소의 두께이고, 100nm는 빛의 투과도를 80% 이상으로 유지할 수 있는 최대의 두께이다.
- [58] 도 4a 및 도 4b에 도시된 예의 경우에, 투명 전극(140)이 형성된 직후 또는 투명 전극(140)이 형성되기 직전에 CNT 또는 그래핀으로 전류 확산층(150)을 형성한다는 점을 제외하면, 나머지 구성은 도 1 내지 도 3을 참조하여 설명한 것과 동일하므로, 구체적인 설명은 생략한다.
- [59]
- [60] 도 5는 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 투명 전극(540)을 구비하는 유기 발광소자의 구조를 도시하는 도면이다.
- [61] 도 5를 참조하면, 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 유기 발광 소자는 Bottom-emission 방식의 유기 발광소자로서, 투명한 유리 또는 플라스틱 재질의 기판(510)위에 제 1 전극(540:이하, "투명 전극"이라 칭함)이 형성되어 있고, 투명 전극(540) 위에 발광층(535)을 포함하는 유기물층(530)과 제 2 전극(520)이 순차적으로 형성되어 있다. 유기물층(530)은 정공 주입층(531), 정공 수송층(533), 발광층(535), 전자 수송층(537), 및 전자 주입층(539)이 차례로 형성된 구조로 구현될 수 있고, 이하에서는 이러한 구조를 예시적으로 설명한다. 투명한 기판(510)과, 정공 주입층(531)부터 제 2 전극(520)까지의 구조는 종래의

일반적인 Bottom-emission 방식의 유기 발광소자에 적용되는 구성과 동일한 구조로 형성될 수 있다.

- [62] 한편, 투명한 기관(510) 위에 형성되는 투명 전극(540)은 상술한 제 1 실시예의 투명 전극(540)과 마찬가지로 저항 변화 물질로 형성되고, 포밍 공정이 수행되어서 내부에 전도성 필라멘트(542)가 형성되고, 이 전도성 필라멘트들(542)은 서로 연결됨으로써 전류가 잘 흐르는 저저항 상태가 유지된다. 따라서, 투명 전극(540)은 가시광 영역의 빛 뿐만 아니라, UV 영역의 빛에 대한 투과도가 매우 높을 뿐만 아니라, 정공 주입층(531)과도 오믹 콘택이 형성되어 유기 발광소자의 구동 전력이 감소된다.

[63]

- [64] 도 6은 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 유기 발광소자의 제조 방법을 설명하는 도면이다.

- [65] 도 6을 참조하여 제 2 실시예에 따른 유기 발광 소자를 제조 방법을 설명하면, 먼저, 투명한 유리 기관(510) 또는 투명한 플라스틱 기관(510)과 같이, bottom emission 방식의 유기 발광소자의 제조에 일반적으로 이용되는 기관(510)위에 저항 변화 물질로 투명 전극(540)(제 1 전극)을 형성한다(도 6의 (a) 참조).

- [66] 그 후, 투명 전극(540) 위에 포토레지스트층(580)을 형성하고, 포토 리소그래피 공정을 수행하여 포토레지스트층(580)에 포밍 전극(582)을 형성하기 위한 패턴을 형성하고(도 6의 (b)참조), e-beam, 스퍼터 또는 기타 금속 증착 공정을 수행하여 패턴 내부에 포밍 전극(582)을 형성한 후, lift-off 공정을 통해서 포밍 전극(582)을 제외한 포토레지스트층(580)을 제거하여 포밍 전극(582)을 완성한다.

- [67] 그 후, 도 6의 (d)에 도시된 바와 같이, 투명 전극(540) 위에 형성된 포밍 전극(582)에 물질에 고유한 임계 전압 이상의 전압을 인가하면, 절연물질인 투명 전극(540) 내부에 전도성 필라멘트(542)가 형성되어, 투명 전극(540)의 저항 상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화된다.

- [68] 투명 전극(540)의 포밍 공정이 수행된 후, 투명 전극(540)위에 정공 주입층(531), 정공 수송층(533), 발광층(535), 전자 수송층(537), 전자 주입층(539), 및 제 2 전극(520)이 순차적으로 형성된다(도 6의 (e)참조). 정공 주입층(531) 내지 제 2 전극(520)을 형성하는 과정은 종래의 bottom emission 방식의 유기 발광소자의 제작 공정이 그대로 적용될 수 있다.

[69]

- [70] 도 7a 및 도 7b는 본 발명의 바람직한 제 2 실시예의 변형 실시예에 따른 유기 발광소자의 구조를 도시하는 도면이다. 도 7a 및 도 7b에 도시된 변형 실시예는 도 4a 및 도 4b에 도시된 제 1 실시예의 변형 실시예와 마찬가지로, 전류 확산 효율을 향상시키기 위해서, 투명 전극(540)의 상면 또는 하면에 접촉하도록 전류 확산층(550)을 CNT 또는 그래핀으로 형성한다. 도 7a에는 투명 전극(540) 위에 전류 확산층(550)을 형성한 예를 도시하였고, 도 7b에는 투명한 기관(510) 위에

전류 확산층(550)을 형성하고, 그 위에 투명 전극(540)을 형성한 예를 도시하였다.

- [71] 도 7a에 도시된 예에서, 정공은 1차적으로 전류 확산층(550)에 의해서 유기 발광 소자 전체 영역으로 확산되어 투명 전극(540)으로 주입되고, 2차적으로 투명 전극(540)에서 유기 발광소자 전체 영역으로 확산됨으로써, 정공 주입층(531)에 균일하게 정공이 주입된다. 또한, 도 7b에 도시된 예에서, 정공은 1차적으로 투명 전극(540)에 의해서 유기 발광 소자 전체 영역으로 확산되어 전류 확산층(550)으로 주입되고, 2차적으로 전류 확산층(550)에서 유기 발광소자 전체 영역으로 확산됨으로써, 정공 주입층(531)에 균일하게 정공이 주입된다.
- [72] 전류 확산층(550)을 포함하는 유기 발광소자는 제조 과정은 투명 전극(540) 형성전 또는 투명 전극(540) 형성후에 전류 확산층(550)을 형성한다는 점만 차이가 있으므로, 구체적인 설명은 생략한다.
- [73]
- [74] 이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

청구범위

- [청구항 1] 기판;
 상기 기판 위에 형성되고, 인가되는 전계에 의해서 저항상태가
 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연
 물질로 형성된 제 1 전극;
 상기 제 1 전극 위에 형성되고, 내부에 발광층을 포함하는
 유기물층; 및
 상기 유기물층 위에 형성되는 제 2 전극;을 포함하는 것을
 특징으로 하는 유기 발광 소자.
- [청구항 2] 기판;
 상기 기판위에 형성된 제 2 전극;
 상기 제 2 전극 위에 형성되고, 내부에 발광층을 포함하는
 유기물층; 및
 상기 유기물층 위에 형성되고, 인가되는 전계에 의해서
 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의
 절연 물질로 형성된 제 1 전극;을 포함하는 것을 특징으로 하는
 유기 발광 소자.
- [청구항 3] 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
 상기 제 1 전극은 고유한 임계 전압 이상의 전압이 인가되어
 포밍(forming) 공정이 수행됨으로써, 내부에 전도성 필라멘트가
 형성된 것을 특징으로 하는 발광 소자.
- [청구항 4] 제 3 항에 있어서,
 상기 유기물층과 상기 제 1 전극 사이에 CNT(Carbon Nano Tube)
 또는 그래핀으로 형성되는 전류확산층을 더 포함하는 것을
 특징으로 하는 유기 발광소자.
- [청구항 5] 제 3 항에 있어서,
 상기 제 1 전극의 상기 유기물층이 접촉하는 면의 반대면에
 접촉하고, CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 형성되는
 전류확산층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자.
- [청구항 6] 제 3 항에 있어서,
 상기 제 1 전극은 상기 유기물층과 오믹 콘택되는 것을 특징으로
 하는 유기 발광소자.
- [청구항 7] 제 3 항에 있어서,
 상기 제 1 전극은 투명한 Oxide 계열의 물질, 투명한 Nitride 계열의
 물질, 투명한 폴리머 계열의 물질, 및 투명한 나노 물질들 중 어느
 하나로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자.
- [청구항 8] 제 3 항에 있어서,

[청구항 9]

상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 및 전자 주입층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.
인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 기판 위에 형성하는 제 1 전극 형성 단계;

[청구항 10]

내부에 발광층을 포함하는 유기물층을 상기 제 1 전극 위에 형성하는 유기물층 형성 단계; 및
상기 유기물층 위에 제 2 전극을 형성하는 제 2 전극 형성 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자 제조 방법.

기판 위에 제 2 전극을 형성하는 제 2 전극 형성 단계;
내부에 발광층을 포함하는 유기물층을 상기 제 2 전극 위에 형성하는 유기물층 형성 단계; 및
인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 상기 유기물층 위에 형성하는 제 1 전극 형성 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자 제조 방법.

[청구항 11]

제 9 항 또는 제 10 항에 있어서, 상기 제 1 전극 형성 단계는
상기 제 1 전극에 임계 전압 이상의 전압을 인가함으로써 포밍(forming) 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극 내부에 전도성 필라멘트를 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자 제조방법.

[청구항 12]

제 11 항에 있어서,
상기 제 1 전극 형성 단계는
CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 전류 확산층을 형성하는 단계;

상기 전류 확산층 위에 인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 형성하는 단계; 및

상기 제 1 전극에 임계 전압 이상의 전압을 인가함으로써 포밍(forming) 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극 내부에 전도성 필라멘트를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자 제조 방법.

[청구항 13]

제 11 항에 있어서,
상기 제 1 전극 형성 단계는
인가되는 전계에 의해서 저항상태가 고저항 상태에서 저저항 상태로 변화되는 투명 재질의 절연물질로 제 1 전극을 형성하는 단계;

상기 제 1 전극에 임계 전압 이상의 전압을 인가함으로써

포밍(forming) 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극 내부에 전도성 필라멘트를 형성하는 단계; 및

상기 제 1 전극 위에, CNT(Carbon Nano Tube) 또는 그래핀으로 전류 확산층을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자 제조 방법.

[청구항 14]

제 11 항에 있어서,

상기 제 1 전극은 상기 유기물층과 오믹 콘택되는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자 제조 방법.

[청구항 15]

제 11 항에 있어서,

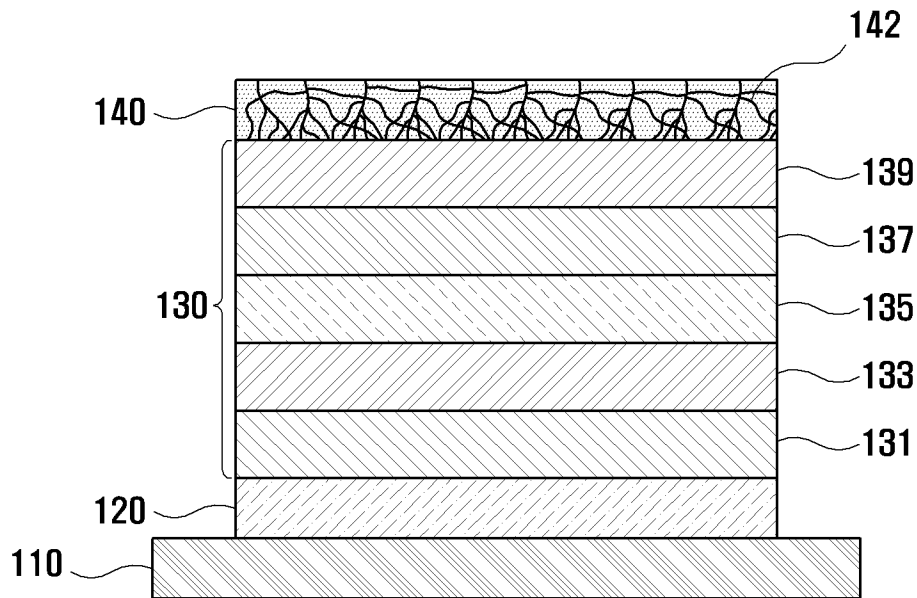
상기 제 1 전극은 투명한 Oxide 계열의 물질, 투명한 Nitride 계열의 물질, 투명한 폴리머 계열의 물질, 및 투명한 나노 물질들 중 어느 하나로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광소자 제조방법.

[청구항 16]

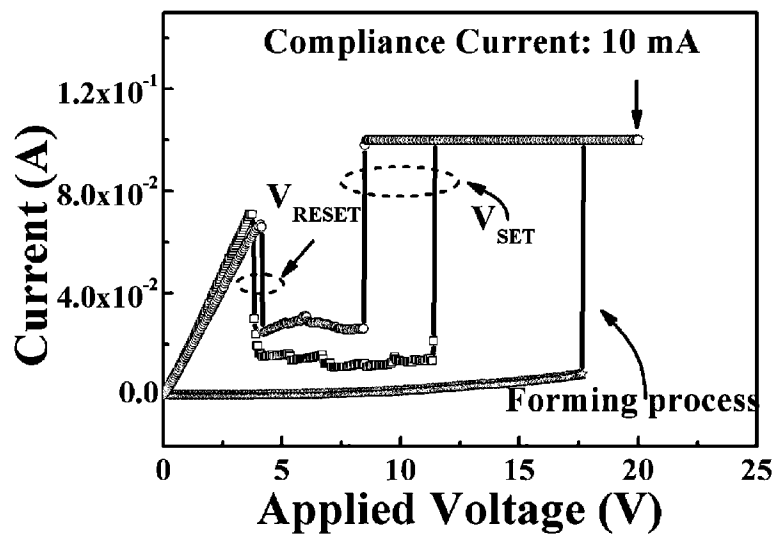
제 11 항에 있어서, 상기 유기물층 형성 단계에서

정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 및 전자 주입층이 순차적으로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자 제조방법.

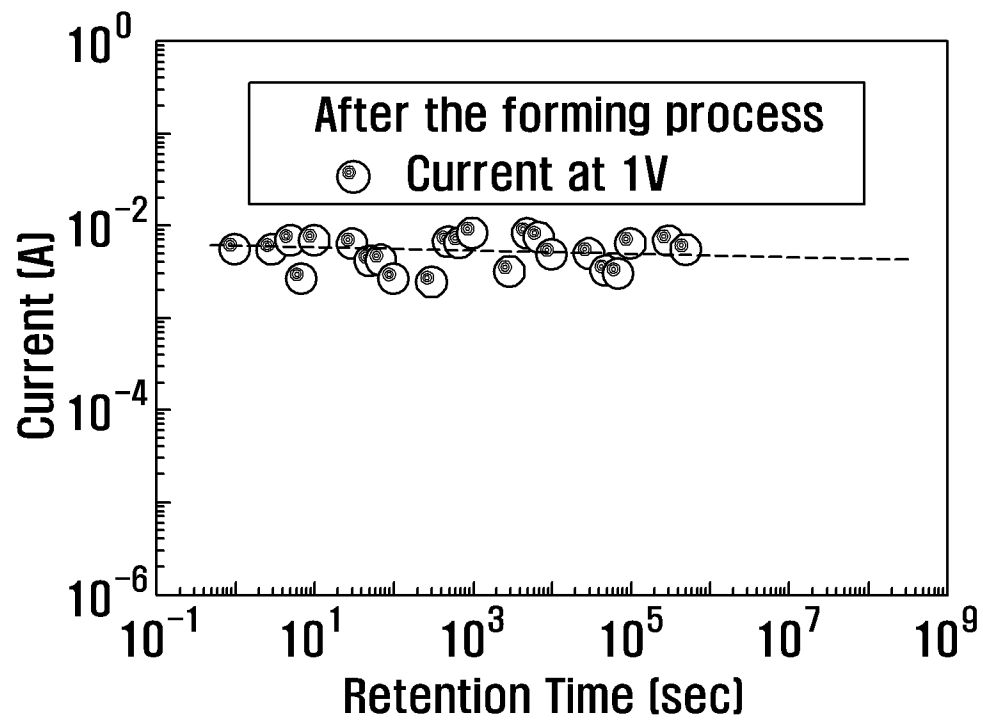
[Fig. 1]



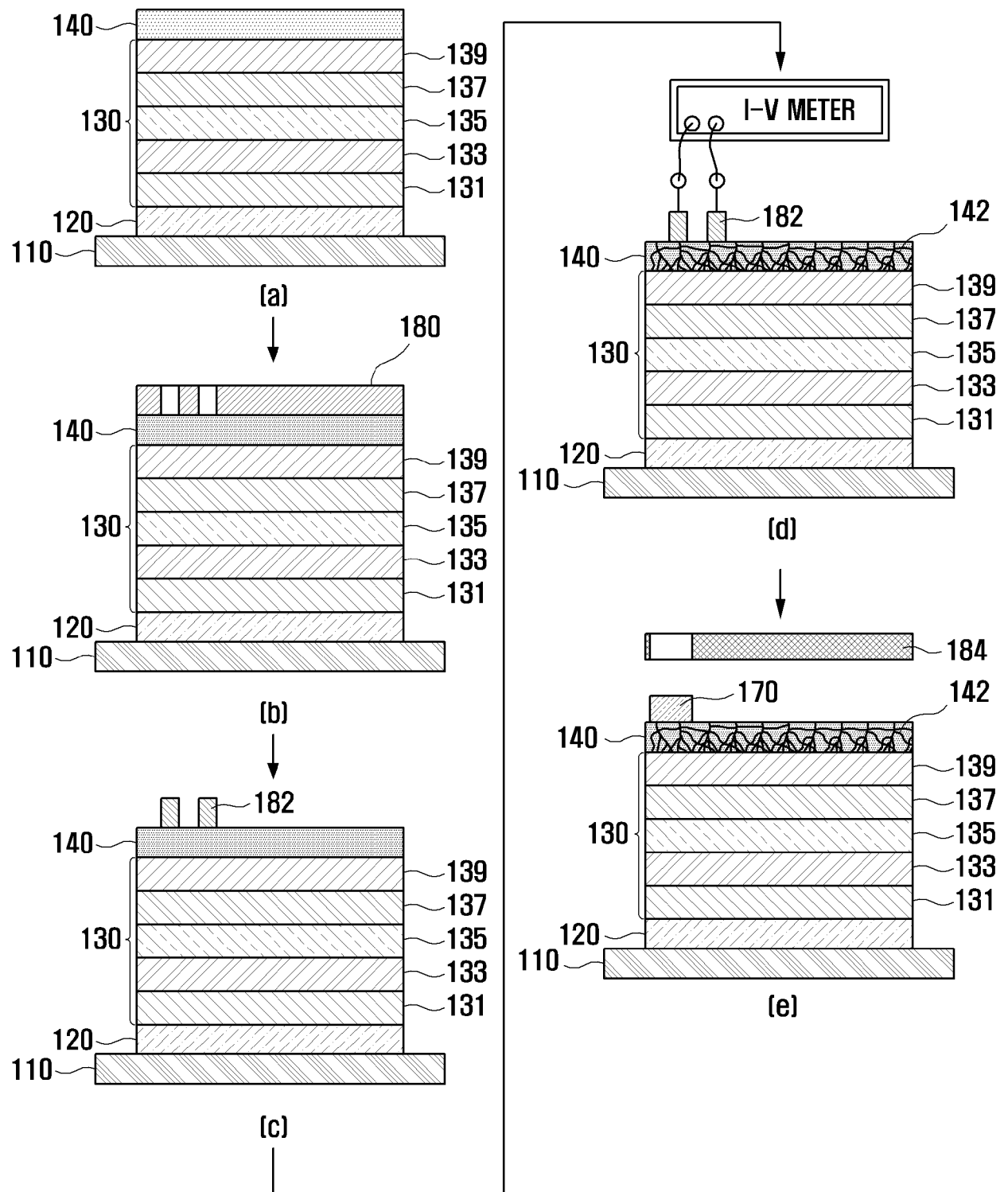
[Fig. 2a]



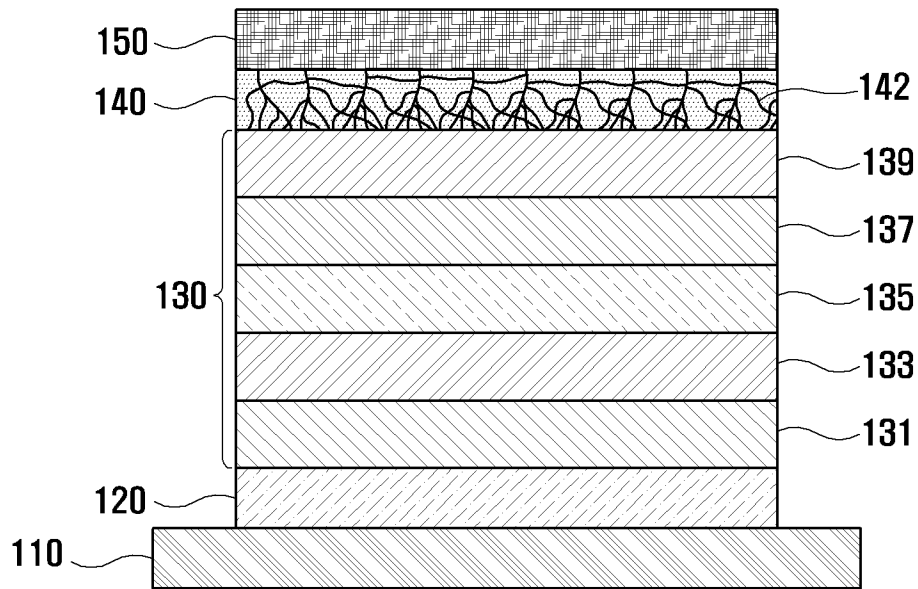
[Fig. 2b]



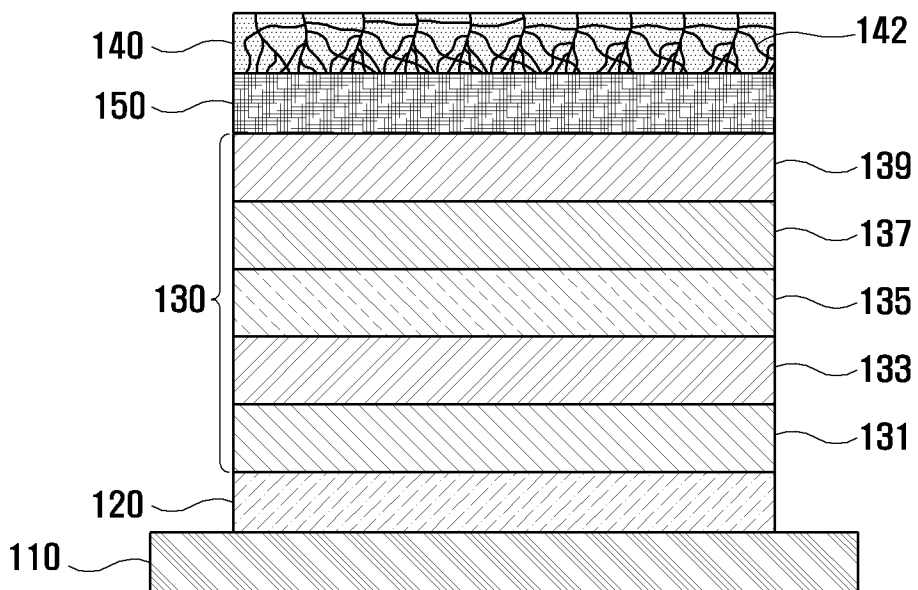
[Fig. 3]



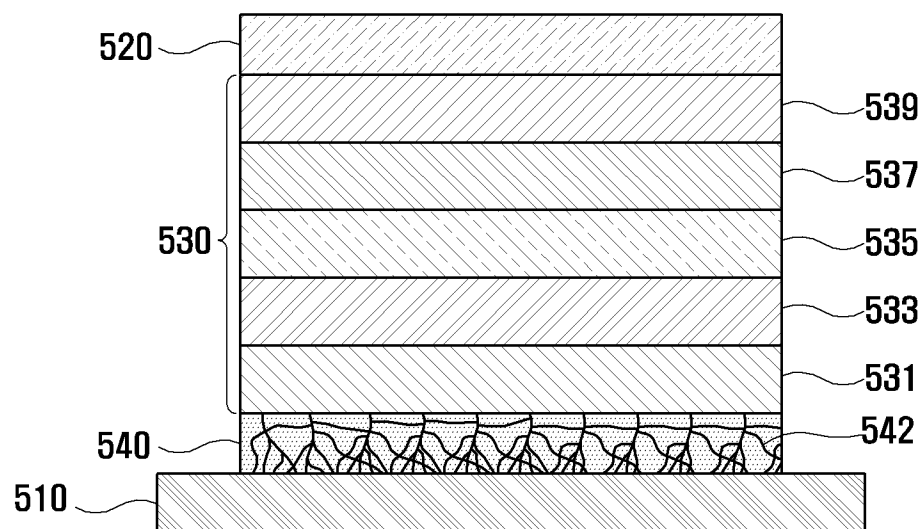
[Fig. 4a]



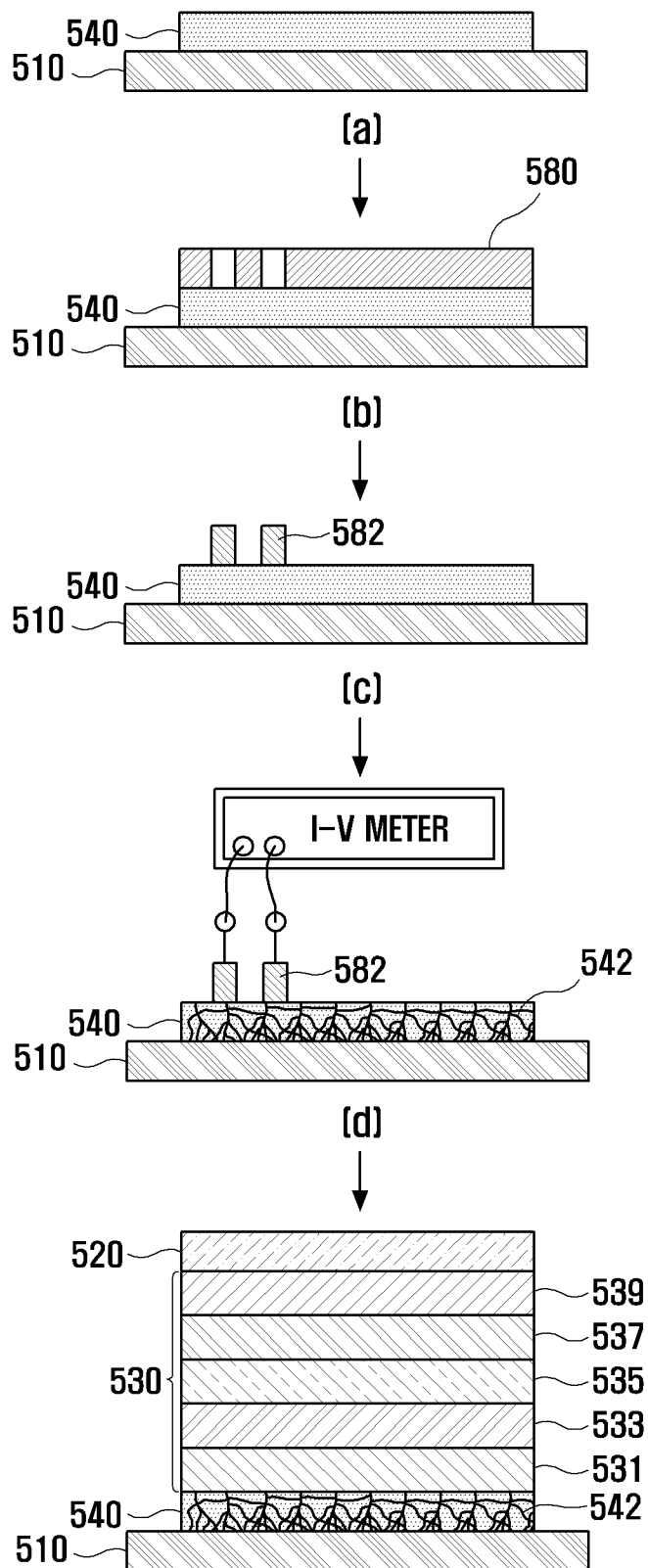
[Fig. 4b]



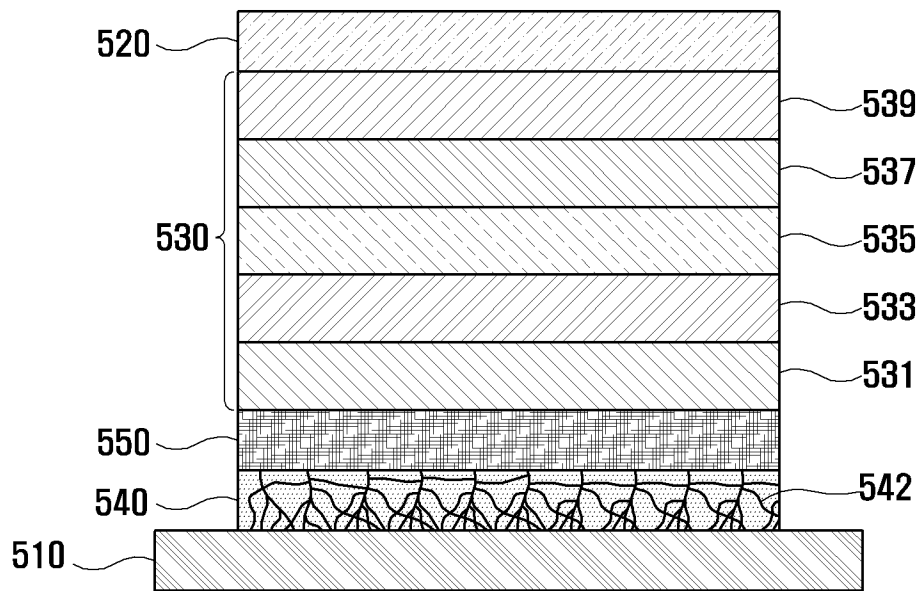
[Fig. 5]



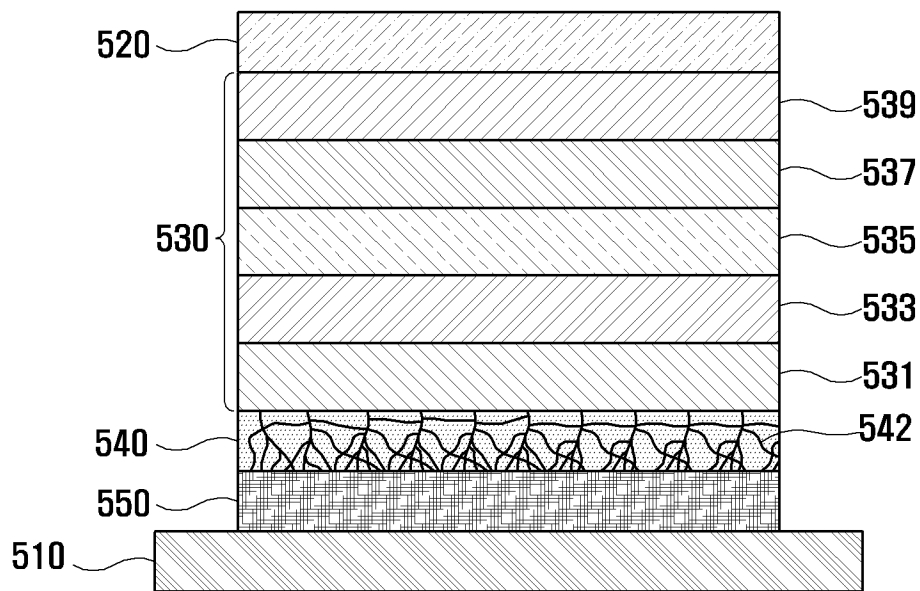
[Fig. 6]



[Fig. 7a]



[Fig. 7b]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2013/004975**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****H01L 51/52(2006.01)i, H05B 33/26(2006.01)i**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L 51/52; H01L 27/115; H01L 51/05; H05B 33/12 ; H05B 33/22; G09F 9/30; H01L 27/105; H05B 33/14; G09G 3/30; H01L 21/8247; H05B 33/26

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above
Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: organic light emitting device, high resistance, low resistance, electrode, electric field, filament, current diffusion layer, critical voltage

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-324683 A (ROHM CO., LTD.) 08 November 2002 See abstract; claim 1; paragraphs [0035]-[0044]; and figure 2.	1-16
A	JP 2007-529906 A (FUJI TECHNOSURVEY CO., LTD. et al.) 25 October 2007 See abstract; claim 1; and figure 7.	1-16
A	KR 10-2010-0077647 A (SK HYNIX INC.) 08 July 2010 See abstract; claims 6, 10; and figure 1C.	1-16
A	KR 10-2009-0125341 A (KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 07 December 2009 See abstract; claim 1; and figure 3.	1-16
A	JP 2003-173876 A (RICOH CO., LTD.) 20 June 2003 See paragraphs [0030]-[0033]; and figure 1.	1-16



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 SEPTEMBER 2013 (11.09.2013)

Date of mailing of the international search report

12 SEPTEMBER 2013 (12.09.2013)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2013/004975

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
JP 2002-324683 A	08/11/2002	US 2002-0190664 A1	19/12/2002
JP 2007-529906 A	25/10/2007	DE 112005000611 T5	24/06/2010
		GB 0618229 D0	25/10/2006
		GB 2429113 A	14/02/2007
		GB 2429113 B	24/06/2009
		US 2007-0252126 A1	01/11/2007
		WO 2005-089288 A2	29/09/2005
		WO 2005-089288 A3	12/10/2006
KR 10-2010-0077647 A	08/07/2010	US 2010-0163819 A1	01/07/2010
KR 10-2009-0125341 A	07/12/2009	NONE	
JP 2003-173876 A	20/06/2003	JP 04162885 B2	08/10/2008

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H01L 51/52(2006.01)i, H05B 33/26(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H01L 51/52; H01L 27/115; H01L 51/05; H05B 33/12; H05B 33/22; G09F 9/30; H01L 27/105; H05B 33/14; G09G 3/30; H01L 21/8247; H05B 33/26

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 유기 발광 소자, 고저항, 저저항, 전극, 전계, 필라멘트, 전류확산층, 임계 전압

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	JP 2002-324683 A (ROHM CO., LTD.) 2002.11.08 요약; 청구항 1; 단락 [0035]-[0044]; 및 도면 2 참조.	1-16
A	JP 2007-529906 A (FUJI TECHNOSURVEY CO., LTD. et al.) 2007.10.25 요약; 청구항 1; 및 도면 7 참조.	1-16
A	KR 10-2010-0077647 A (주식회사 하이닉스반도체) 2010.07.08 요약; 청구항 6, 10; 및 도면 1C 참조.	1-16
A	KR 10-2009-0125341 A (한국과학기술원) 2009.12.07 요약; 청구항 1; 및 도면 3 참조.	1-16
A	JP 2003-173876 A (RICOH CO., LTD.) 2003.06.20 단락 [0030]-[0033]; 및 도면 1 참조.	1-16

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2013년 09월 11일 (11.09.2013)

국제조사보고서 발송일

2013년 09월 12일 (12.09.2013)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

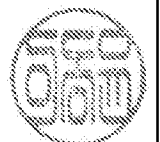
 대한민국 특허청
(302-701) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-472-7140

심사관

이동운

전화번호 +82-42-481-8734



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
JP 2002-324683 A	2002/11/08	US 2002-0190664 A1	2002/12/19
JP 2007-529906 A	2007/10/25	DE 112005000611 T5	2010/06/24
		GB 0618229 D0	2006/10/25
		GB 2429113 A	2007/02/14
		GB 2429113 B	2009/06/24
		US 2007-0252126 A1	2007/11/01
		WO 2005-089288 A2	2005/09/29
		WO 2005-089288 A3	2006/10/12
KR 10-2010-0077647 A	2010/07/08	US 2010-0163819 A1	2010/07/01
KR 10-2009-0125341 A	2009/12/07	없음	
JP 2003-173876 A	2003/06/20	JP 04162885 B2	2008/10/08